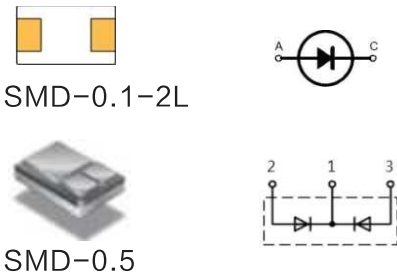


JXCCS30S1 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS30S1

$I_{F(AV)}: 1A$

$V_{RMM} \geq 30V$

$V_F \leq 0.43V$

电特性:

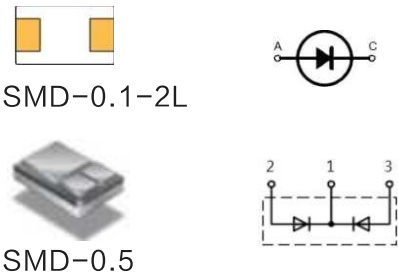
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	30	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.55	V	@ 1A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.43		@ 1A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	70	μA	$V_R = 30V$ $T_J = 25^{\circ}C$
		500		$V_R = 30V$ $T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS30S2 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS30S2

$I_{F(AV)}: 2A$

$V_{RMM} \geq 30V$

$V_F \leq 0.4V$

电特性:

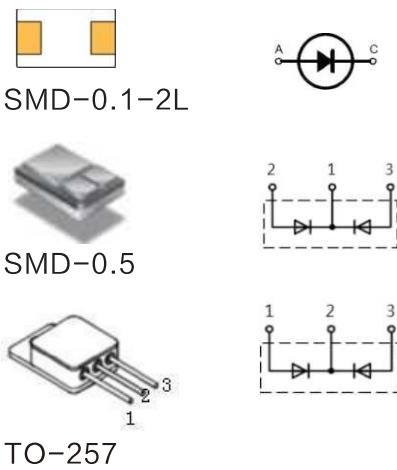
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	30	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.55	V	@ 2A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.44		@ 2A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	250	μA	$V_R = 30V$ $T_J = 25^{\circ}C$
		1000		$V_R = 30V$ $T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS30S3 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS30S3

$I_{F(AV)}: 3A$

$V_{RMM} \geq 30V$

$V_F \leq 0.49V$

电特性:

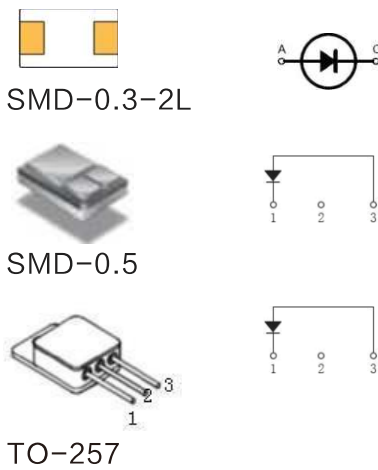
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	30	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.6	V	@ 3A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.49		@ 3A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	300	μA	$V_R = 30V$ $T_J = 25^{\circ}C$
		1000		$V_R = 30V$ $T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS30S15 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS30S15

$I_{F(AV)}: 15A$

$V_{RMM} \geq 30V$

$V_F \leq 0.51V$

电特性:

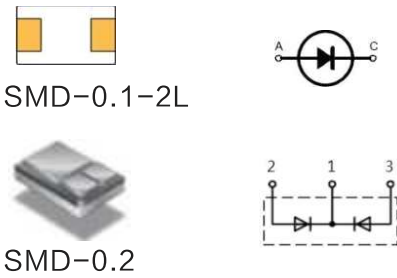
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	30	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.65	V	@ 15A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.51		@ 15A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	90	μA	$V_R = 30V$ $T_J = 25^{\circ}C$
		500		$V_R = 30V$ $T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS45S1 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS45S1

$I_{F(AV)}: 1A$

$V_{RMM} \geq 45V$

$V_F \leq 0.4V$

电特性:

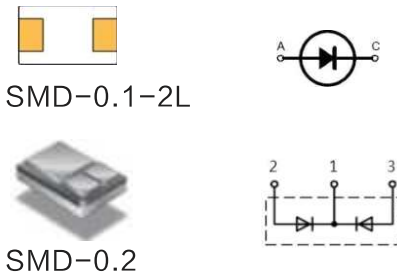
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	45	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.55	V	@ 1A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.4		@ 1A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	60	μA	$V_R = 45V$ $T_J = 25^{\circ}C$
		500		$V_R = 45V$ $T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS45S3 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS45S3

$I_{F(AV)}: 3A$

$V_{RMM} \geq 45V$

$V_F \leq 0.6V$

电特性:

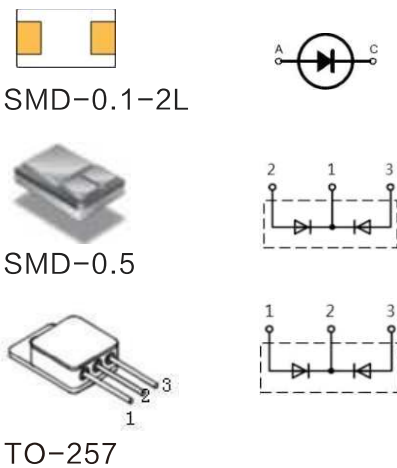
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	45	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.7	V	@ 3A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.6		@ 3A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	20	μA	$V_R = 45V$ $T_J = 25^{\circ}C$
		200		$V_R = 45V$ $T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS45S5 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS45S5

$I_{F(AV)}: 5A$

$V_{RMM} \geq 45V$

$V_F \leq 0.54V$

电特性:

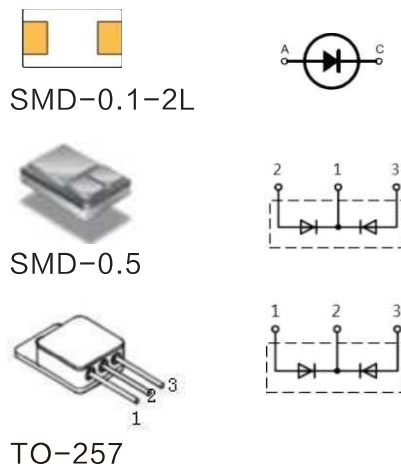
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	45	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.65	V	@5A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.54		@5A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	20	uA	$V_R = 45V$ $T_J = 25^{\circ}C$
		200		$V_R = 45V$ $T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS45S10 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS45S10

$I_{F(AV)}: 5A$

$V_{RMM} \geq 45V$

$V_F \leq 0.54V$

电特性:

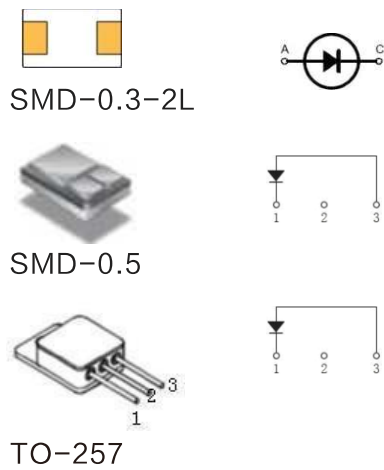
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	45	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.65	V	@5A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.54		@5A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	20	uA	$V_R = 45V$ $T_J = 25^{\circ}C$
		200		$V_R = 45V$ $T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS45S15 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS45S15

$I_{F(AV)}: 15A$

$V_{RMM} \geq 45V$

$V_F \leq 0.59V$

电特性:

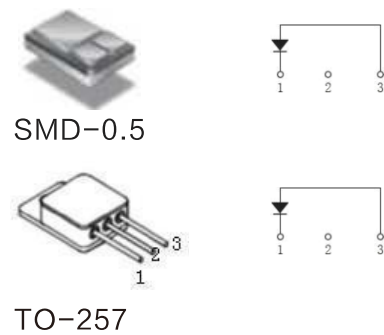
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	45	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.75	V	@ 15A, $T_J = -55^\circ C$
		0.59		@ 15A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	12	μA	$V_R = 45V$ $T_J = 25^\circ C$
		200		$V_R = 45V$ $T_J = 125^\circ C$

JXCCS45S20 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS45S20

$I_{F(AV)}: 20A$

$V_{RMM} \geq 45V$

$V_F \leq 0.56V$

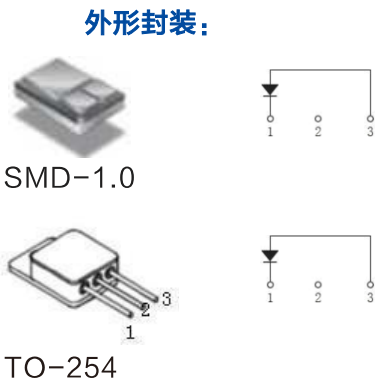
电特性:

符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	45	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.75	V	@ 20A, $T_J = -55^\circ C$
		0.56		@ 20A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	40	μA	$V_R = 45V$ $T_J = 25^\circ C$
		200		$V_R = 45V$ $T_J = 125^\circ C$

JXCCS45S30 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小



JXCCS45S30

$I_{F(AV)}: 30A$

$V_{RMM} \geq 45V$

$V_F \leq 0.55V$

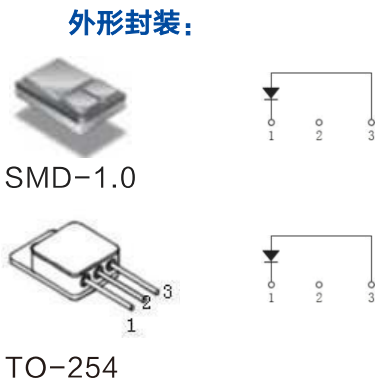
电特性:

符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	45	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.75	V	@ 30A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.55		@ 30A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	60	uA	$V_R = 45V$ $T_J = 25^{\circ}C$
		200		$V_R = 45V$ $T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS45S60 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小



JXCCS45S60

$I_{F(AV)}: 60A$

$V_{RMM} \geq 45V$

$V_F \leq 0.57V$

电特性:

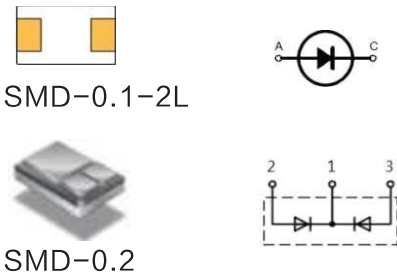
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	45	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.75	V	@ 60A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.57		@ 60A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	60	uA	$V_R = 45V$ $T_J = 25^{\circ}C$
		200		$V_R = 45V$ $T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS60S1 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS60S1

$I_{F(AV)}: 1A$

$V_{RMM} \geq 60V$

$V_F \leq 0.5V$

电特性:

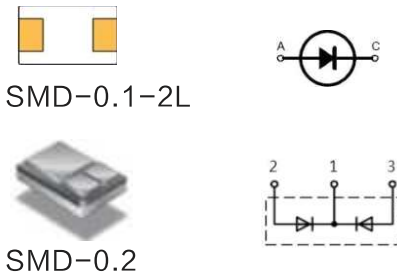
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	60	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.6	V	@ 1A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.5		@ 1A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	35	μA	$V_R = 60V$ $T_J = 25^{\circ}C$
		200		$V_R = 60V$ $T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS60S3 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS60S3

$I_{F(AV)}: 3A$

$V_{RMM} \geq 60V$

$V_F \leq 0.61V$

电特性:

符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	60	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.75	V	@ 3A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.61		@ 3A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	8	μA	$V_R = 60V$ $T_J = 25^{\circ}C$
		200		$V_R = 60V$ $T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS60S5 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

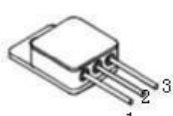
外形封装:



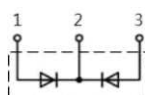
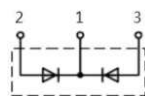
SMD-0.1-2L



SMD-0.5



TO-257



JXCCS60S5

$$I_{F(AV)}: 5A$$

$$V_{RMM} \geq 60V$$

$$V_F \leq 0.5V$$

电特性:

符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	60	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.65	V	@ 5A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.5		@ 5A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	100	uA	$V_R = 60V \ T_J = 25^{\circ}C$
		500		$V_R = 60V \ T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS60S10 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

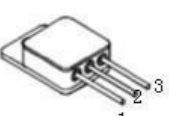
外形封装:



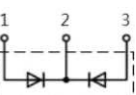
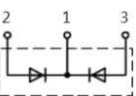
SMD-0.3-2L



SMD-0.5



TO-257



JXCCS60S10

$$I_{F(AV)}: 10A$$

$$V_{RMM} \geq 60V$$

$$V_F \leq 0.66V$$

电特性:

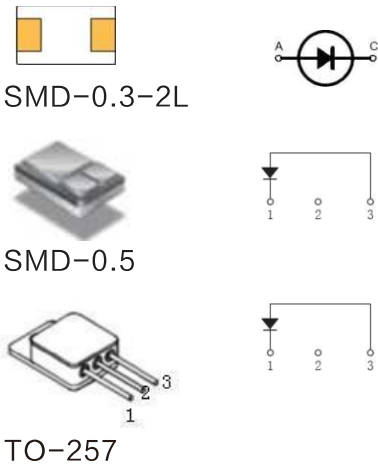
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	60	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.75	V	@ 10A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.66		@ 10A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	60	uA	$V_R = 60V \ T_J = 25^{\circ}C$
		200		$V_R = 60V \ T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS60S15 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS60S15

$I_{F(AV)}: 15A$

$V_{RMM} \geq 60V$

$V_F \leq 0.72V$

电特性:

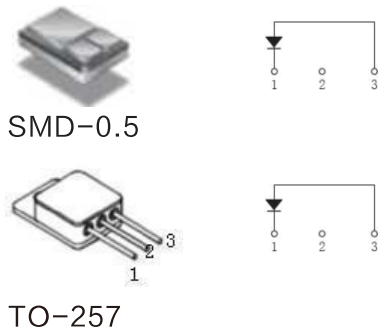
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	60	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.85	V	@ 15A, $T_J = -55^\circ C$
		0.72		@ 15A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	10	μA	$V_R = 60V$ $T_J = 25^\circ C$
		200		$V_R = 60V$ $T_J = 125^\circ C$

JXCCS60S20 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS60S20

$I_{F(AV)}: 20A$

$V_{RMM} \geq 60V$

$V_F \leq 0.67V$

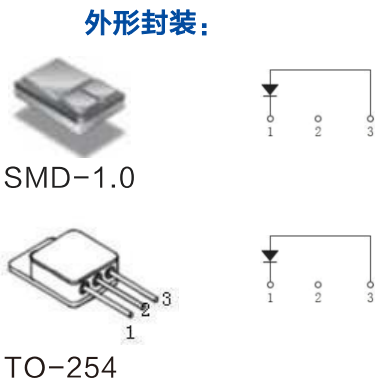
电特性:

符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	60	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.75	V	@ 20A, $T_J = -55^\circ C$
		0.67		@ 20A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	60	μA	$V_R = 60V$ $T_J = 25^\circ C$
		200		$V_R = 60V$ $T_J = 125^\circ C$

JXCCS60S30 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小



JXCCS60S30

$I_{F(AV)}: 30A$

$V_{RMM} \geq 60V$

$V_F \leq 0.67V$

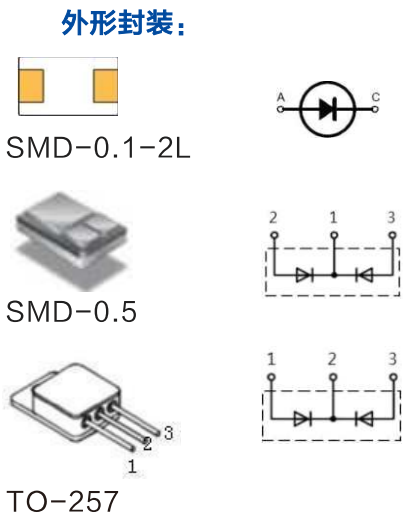
电特性:

符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	60	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.75	V	@ 30A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.67		@ 30A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	60	μA	$V_R = 60V$ $T_J = 25^{\circ}C$
		200		$V_R = 60V$ $T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS100S5 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小



JXCCS100S5

$I_{F(AV)}: 5A$

$V_{RMM} \geq 100V$

$V_F \leq 0.78V$

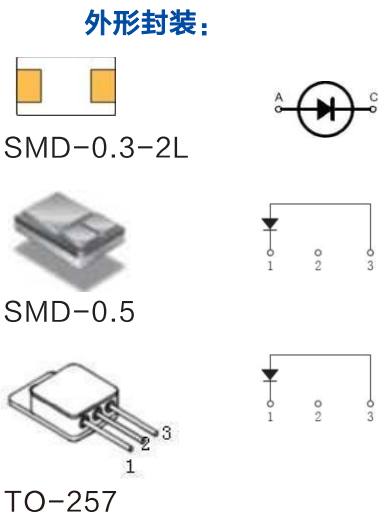
电特性:

符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	100	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.95	V	@ 5A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.78		@ 5A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	300	μA	$V_R = 100V$ $T_J = 25^{\circ}C$
		1000		$V_R = 100V$ $T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS100S10 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小



JXCCS100S10

$I_{F(AV)}: 10A$

$V_{RMM} \geq 100V$

$V_F \leq 0.76V$

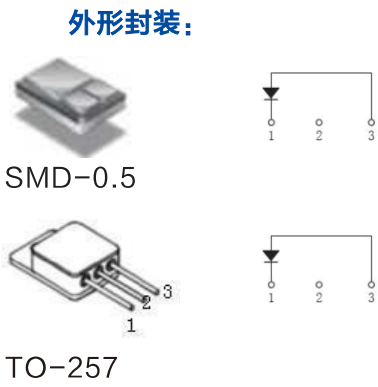
电特性:

符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	100	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.85	V	@ 10A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.76		@ 10A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	10	μA	$V_R = 100V$ $T_J = 25^{\circ}C$
		200		$V_R = 100V$ $T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS100S20 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小



JXCCS100S20

$I_{F(AV)}: 20A$

$V_{RMM} \geq 100V$

$V_F \leq 0.74V$

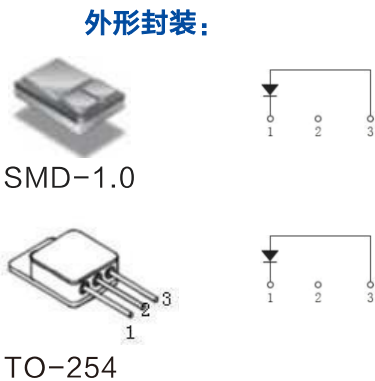
电特性:

符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	100	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.85	V	@ 20A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.74		@ 20A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	50	μA	$V_R = 100V$ $T_J = 25^{\circ}C$
		200		$V_R = 100V$ $T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS100S30 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小



JXCCS100S30

$I_{F(AV)}: 30A$

$V_{RMM} \geq 100V$

$V_F \leq 0.87V$

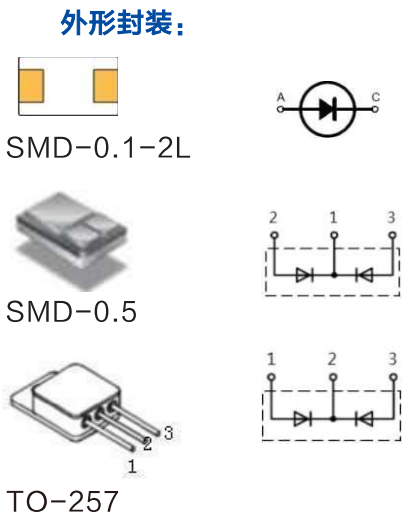
电特性:

符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	100	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.95	V	@ 30A, $T_J = -55^\circ C$
		0.87		@ 30A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	150	uA	$V_R = 100V$ $T_J = 25^\circ C$
		500		$V_R = 100V$ $T_J = 125^\circ C$

JXCCS150S5 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小



JXCCS150S5

$I_{F(AV)}: 5A$

$V_{RMM} \geq 150V$

$V_F \leq 0.8V$

电特性:

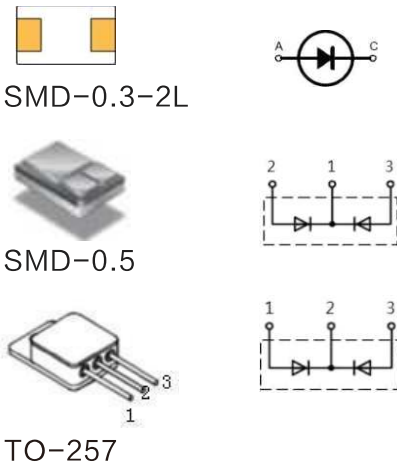
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	150	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.95	V	@ 5A, $T_J = -55^\circ C$
		0.8		@ 5A, $T_J = 25^\circ C$
I_R	反向漏电	20	uA	$V_R = 150V$ $T_J = 25^\circ C$
		200		$V_R = 150V$ $T_J = 125^\circ C$

JXCCS150S10 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS150S10

$I_{F(AV)}: 10A$

$V_{RMM} \geq 150V$

$V_F \leq 0.81V$

电特性:

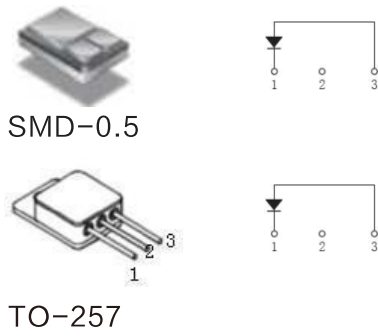
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	150	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.95	V	@ 10A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.81		@ 10A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	10	uA	$V_R = 150V$ $T_J = 25^{\circ}C$
		200		$V_R = 150V$ $T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS150S20 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS150S20

$I_{F(AV)}: 20A$

$V_{RMM} \geq 150V$

$V_F \leq 0.8V$

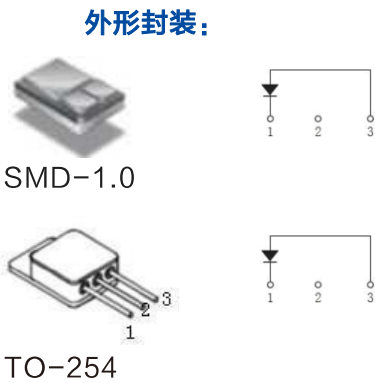
电特性:

符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	150	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.95	V	@ 20A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.8		@ 20A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	50	uA	$V_R = 150V$ $T_J = 25^{\circ}C$
		500		$V_R = 150V$ $T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS150S30 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小



JXCCS150S30

$I_{F(AV)}: 30A$

$V_{RMM} \geq 150V$

$V_F \leq 0.84V$

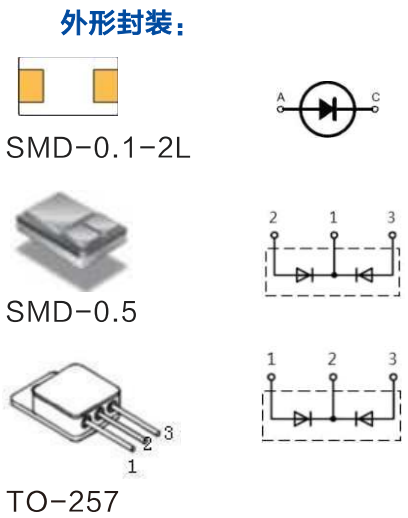
电特性:

符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	150	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.95	V	@ 30A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.84		@ 30A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	50	μA	$V_R = 150V$ $T_J = 25^{\circ}C$
		500		$V_R = 150V$ $T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS200S5 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小



JXCCS200S5

$I_{F(AV)}: 5A$

$V_{RMM} \geq 200V$

$V_F \leq 0.85V$

电特性:

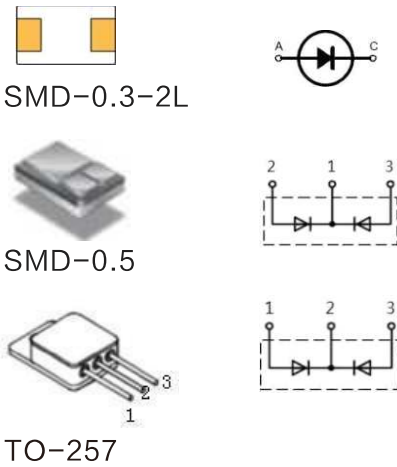
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	200	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.95	V	@ 5A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.85		@ 5A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	4	μA	$V_R = 200V$ $T_J = 25^{\circ}C$
		100		$V_R = 200V$ $T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS200S10 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS200S10

$I_{F(AV)}: 10A$

$V_{RMM} \geq 200V$

$V_F \leq 0.84V$

电特性:

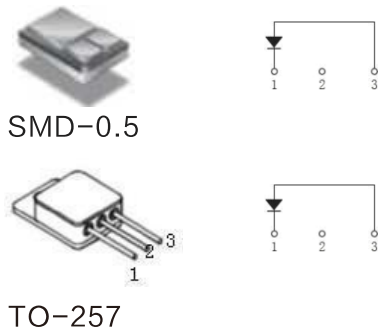
符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	200	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.95	V	@ 10A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.84		@ 10A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	8	μA	$V_R = 200V$ $T_J = 25^{\circ}C$
		100		$V_R = 200V$ $T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS200S20 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小

外形封装:



JXCCS200S20

$I_{F(AV)}: 20A$

$V_{RMM} \geq 200V$

$V_F \leq 0.82V$

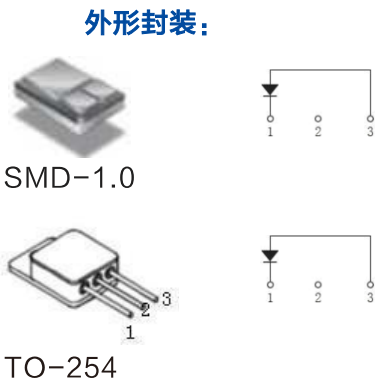
电特性:

符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	200	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.95	V	@ 20A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.82		@ 20A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	15	μA	$V_R = 200V$ $T_J = 25^{\circ}C$
		100		$V_R = 200V$ $T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS200S30 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小



JXCCS200S30

$I_{F(AV)}: 30A$

$V_{RMM} \geq 200V$

$V_F \leq 0.85V$

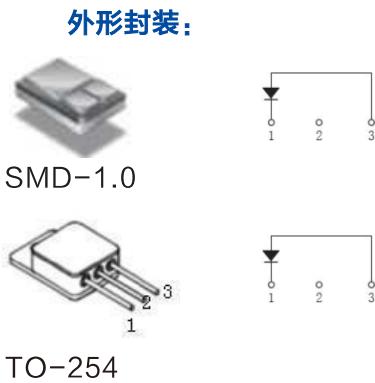
电特性:

符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	200	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.95	V	@ 30A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.85		@ 30A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	1.5	μA	$V_R = 200V$ $T_J = 25^{\circ}C$
		100		$V_R = 200V$ $T_J = 125^{\circ}C$

JXCCS200S40 肖特基二极管

特性:

- (1) 标准封装
- (2) 低压降
- (3) 低开关损耗
- (4) 漏电小



JXCCS200S40

$I_{F(AV)}: 40A$

$V_{RMM} \geq 200V$

$V_F \leq 0.87V$

电特性:

符号	参数	极限值	单位	条件
V_{RRM}	峰值反向电压	200	V	$I_R = 100\mu A$
V_F	正向压降	0.95	V	@ 40A, $T_J = -55^{\circ}C$
		0.87		@ 40A, $T_J = 25^{\circ}C$
I_R	反向漏电	150	μA	$V_R = 200V$ $T_J = 25^{\circ}C$
		500		$V_R = 200V$ $T_J = 125^{\circ}C$